

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形トランジスタ

2SD356, 2SD357, 2SD358

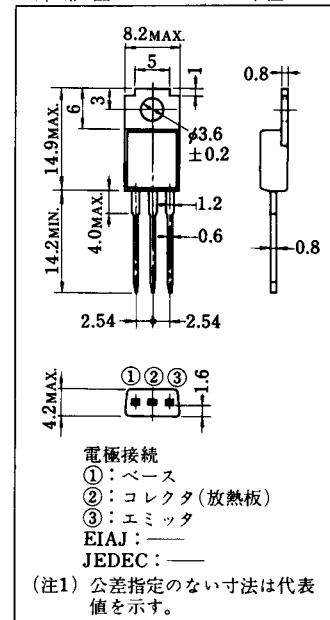
40~70W出力 コンプリメンタリドライブ用

- 高耐圧 ( $V_{CEO}=80V, 100V, 120V$ )。
- 破壊耐量が大きい。
- $h_{FE}$ の直線性が良い。
- モールドパワートランジスタで、小形かつ取付けが容易です。
- 2SB526, 2SB527, 2SB528とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

最大定格 (周囲温度 25°C)

項目	記号	定 格 値			単 位
		2SD356	2SD357	2SD358	
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	90	110	130	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	5	5	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	80	100	120	V
コレクタ電流	$I_C$	800			mA
コレクタ損失	$T_a=25^\circ C$	$P_C$			W
	$T_c=25^\circ C$	$P_C$			W
接合部温度	$T_j$	+150			°C
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150			°C

外形図 単位: mm



電気的特性 (周囲温度 25°C)

項目	記号	測定条件	2SD356			2SD357			2SD358			単位
			最小	標準	最大	最小	標準	最大	最小	標準	最大	
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=1mA, I_E=0$	90	—	—	110	—	—	130	—	—	V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1mA, I_C=0$	5	—	—	5	—	—	5	—	—	V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10mA, R_{BE}=\infty$	80	—	—	100	—	—	120	—	—	V
コレクタしや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=25V, I_E=0$	—	—	10	—	—	10	—	—	10	$\mu A$
コレクタしや断電流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=80V, R_{BE}=\infty$	—	—	1	—	—	—	—	—	—	mA
コレクタしや断電流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=100V, R_{BE}=\infty$	—	—	—	—	—	1	—	—	—	mA
コレクタしや断電流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=120V, R_{BE}=\infty$	—	—	—	—	—	—	—	—	1	mA
エミッタしや断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	10	—	—	10	—	—	10	$\mu A$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=4V, I_C=0.3A$ , パルステスト	55	100	300	55	100	300	55	100	300	—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=0.3A, I_B=0.03A$	—	—	1	—	—	1	—	—	1	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=4V, I_C=0.05A$	—	0.7	—	—	0.7	—	—	0.7	—	V

$h_{FE}$  の値により下表のようにアイテム分類を行なっています。

アイテム	C	D	E
$h_{FE}$	55~110	90~180	150~300